

管脚封装说明

管脚图	序号	名称	功能说明
 <p>SOT23-3L</p>	1	VDD	芯片电源正电
	2	Drain	内部高压MOSFET的漏极
	3	CS	芯片参考地，也是峰值电流检管脚

输出功率表

封装类型	最大输出电流@15-265V AC/DC
SOT23-3L	100mA

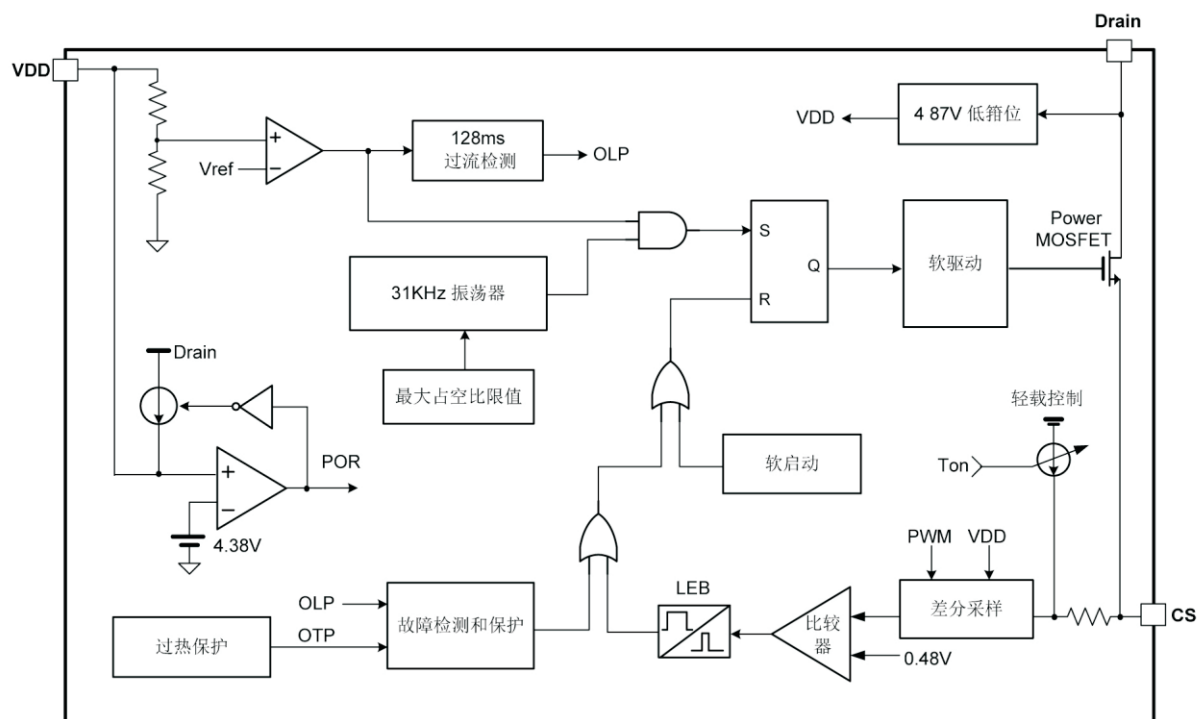
备注：

- 默认5V降压输出。
- 实行输出功率取决于输出电压和散热条件

订货信息

型号	描述
YTE608	SOT23-3L,无卤、编带盘装，2500颗/卷

内部功能框图



高性能、低成本离线式PWM控制开关

极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
VDD 直流供电电压	7	V
Drain 管脚	-0.3 to 500	V
封装热阻---结到环境(SOT23-3L)	260	°C/W
芯片工作结温	160	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	kV
ESD 能力 (机器模型)	250	V

推荐工作条件 (备注 2)

参数	数值	单位
芯片工作结温	-40 to 125	°C

电气参数 (无特殊注明, 环境温度为 25 °C)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
供电部分(VDD 管脚)						
$I_{VDD_standby}$	VDD 静态工作电流	VDD=6V		150	300	uA
V_{DD_Op}	VDD 正常工作电压	满载输出	5.34	5.46	5.58	V
V_{DD_OFF}	VDD 欠压保护电压			4.38		V
V_{DD_ON}	VDD 启动电压			4.87		V
V_{out_Reg}	输出电压基准		4.95	5	5.075	V
振荡器部分						
F_{OSC}	振荡器频率	VDD=5.46V	28.2	31	34.5	KHz
$\Delta F(shuffle) / F_{OSC}$	抖频范围		-5		5	%
$T(shuffle)$	抖频周期			32		ms

高性能、低成本离线式PWM控制开关

D_{MAX}	最大占空比	(备注3)	24.9	25	25.1	%
T_{D_OLP}	过流保护检测周期	VDD=5.46V		128		ms
电流采样部分 (CS 管脚)						
T_{LEB}	前沿消隐			300		ns
$V_{CS(max)}$	过流保护阈值		440	480	520	mV
T_{D_OCP}	过流保护延时			100		ns
过热保护部分						
T_{SD}	过热保护阈值	(备注 3)		155		°C
高压 MOSFET 部分 (Drain 管脚)						
V_{BR}	高压 MOSFET 击穿电压		500			V
R_{dson}	导通阻抗	I(Drain)=50mA		13		ohm
$I_{Drain_to_VDD}$	高压供电电流	Drain=500V, VDD=0V		1	3	mA
$I_{Drain_leakage}$	高压漏电电流	HV=500V, VDD=6V			50	uA

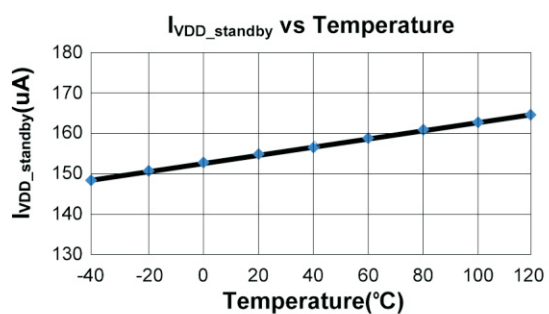
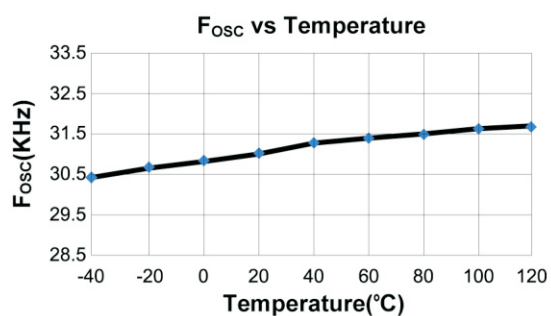
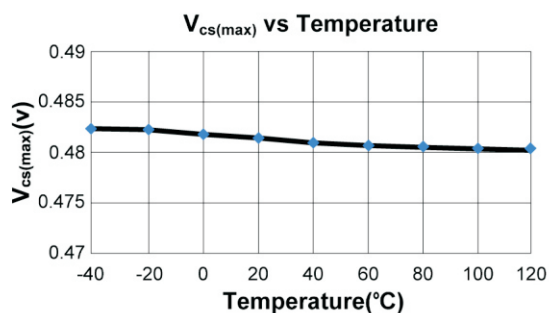
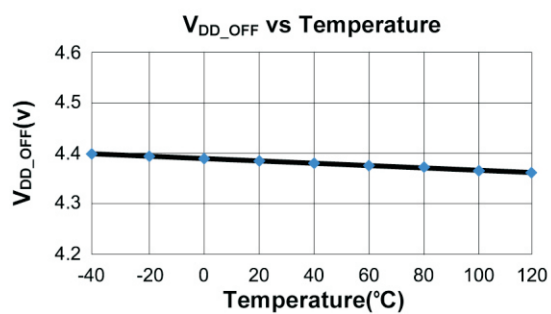
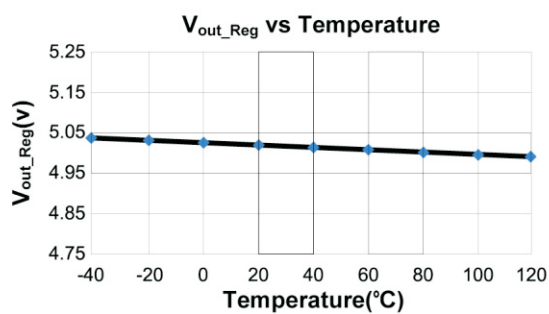
备注1: 超出列表中"极限参数"可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在这些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

备注2: 在超出以上参数的条件下，无法保障芯片的正常运行。

备注3: 参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

备注 4: 器件为 ESD 敏感元件，建议使用中谨慎处理。

参数特性曲线



高性能、低成本离线式PWM控制开关

功能描述

YTE608 采用高压集成工艺，内部集成有 500V 高压 MOSFET，适用于小家电和辅助电源应用场合所需的离线式降压电路和升降压电路，也可用于线性电源的替代型电源。芯片采用开关式峰值电流模式控制，默认 5V 高精度输出时最大程度降低了系统成本。此外，芯片经过内部优化，可兼容超低压输入 (15Vdc 以上) 应用。

超低静态工作电流

YTE608 的静态工作电流典型值为 150uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求，同时也可以帮助系统降低成本。通常条件下建议使用 0.1-1uF 瓷片电容。

振荡器

芯片内部最小 Toff 时间固定为 32us，同时为了优化系统 EMI 系统还带有 5% 范围的抖频功能。在实际工作中，系统开关频率取决于负载状态以及 VDD 电压与输出电压基准的高低，所以系统工作在调频模式中。

逐周期电流限制

芯片内部差分采样电路采样流经高压 MOS 电流的压差作为内部过流比较器的输入。当过流比较器翻转时高压 MOSFET 关断直至下一个周期重新开通。为了避免开通瞬间的干扰，芯片内设计有前沿消隐电路 (典型值 400ns)，在此时间内过流比较器不翻转且高压 MOSFET 不允许关断。

轻载模式

在轻载条件下，系统工作在断续模式下。故实际输入功率取决于电感电流峰值大小。为了降低系统损耗，随着负载的降低 YTE608 会自动降低峰值电流基准以满足超低待机的要求。

软驱动

YTE608 设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统 EMI 性能。

软启动

YTE608 内集成有 4ms (典型值) 周期的软启动功能，当芯片第一次启动时过流保护阈值逐渐增加，而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

过载保护 (OLP)、短路保护 (SLP)

当过流或短路情况发生时，输出电压和 VDD 将降低，如果在 128ms (典型值) 的时间内每次振荡器的周期里高压 MOSFET 都被开通，则芯片识别此情况为过流或短路故障已发生，并停止开关动作之后进入自动重启模式 (如下描述)。

异常过流保护 (AOCP)

在某些情况下 (如重载或者输出短路等)，系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏，芯片内部设计有异常过流检测模块 (AOCP，典型阈值为 250mA)。当 CS 电压高于该阈值时，内部功率 MOSFET 即刻关断并保持关断状态持续 2 个周期。

过热保护 (OTP)

YTE608 内部集成的过热保护电路会检测芯片的芯片结温，当芯片结温超过 155 度 (典型值) 时系统进入到自动重启模式 (如下描述)。

自动重启保护

当过流或者过热故障发生时，芯片进入到自动重启和 VDD 振荡模式中。在此过程中高压 MOSFET 不允许导通，同时 VDD 电容上电压持续在 4.87V 和 4.38V 之间振荡。通过芯片内部数字计数器对振荡周期的计数，当振荡周期数超过 511 次时芯片退出保护模式并重新开始工作。如果故障解除，系统开始工作；否则系统再次进入震荡模式。

高性能、低成本离线式PWM控制开关

典型参数选择

感量计算

为确保系统工作稳定，推荐 YTE608系统工作于浅度 CCM 状态，即电感电流纹波 ΔI 接近于 OCP 峰值电流 (210mA)。具体感量计算公式如下：

$$L = (V_o + V_f) * T_{off_min} / \Delta I$$

其中：

V_o ：输出电压；

V_f ：续流二极管压降；

T_{off_min} ：IC 设定 内部最小 Toff时间，约 32us；

ΔI ：电感纹波电流，CCM 条件下为 $2 * (I_{ocp} - I_{o_max})$ 。

举例来讲，参考 5V -100mA 输出规格，设定 I_{o_max} 为额定输出电流的 1.2 倍，即 120mA；有：

典型应用电路

$$L = (5V + 0.7V) * 32\mu s / (210 - 120)mA / 2 = 1.01mH.$$

此处，选择感量 $L = 1mH$ 、饱和电流 $I_{sat} > 210mA$ (I_{ocp}) 的电感，即为推荐的感量设计参数。

输出电容和假负载选择

输出电容选择：对于常规的 5V -100mA 规格，输出电容根据实际纹波电压需求选择 100uF -220uF 即可。

假负载选择：需在空载输出电压和待机损耗上折中：即过大的假负载可以压制空载输出上飘电压，但系统待机损耗也随之加大；而过小的假负载则反之。一般而言，YTE608系统推荐假负载阻值范围在 1-2k 范围内(随输出电压调整)，假负载损耗控制在 10-15mW 左右即可。

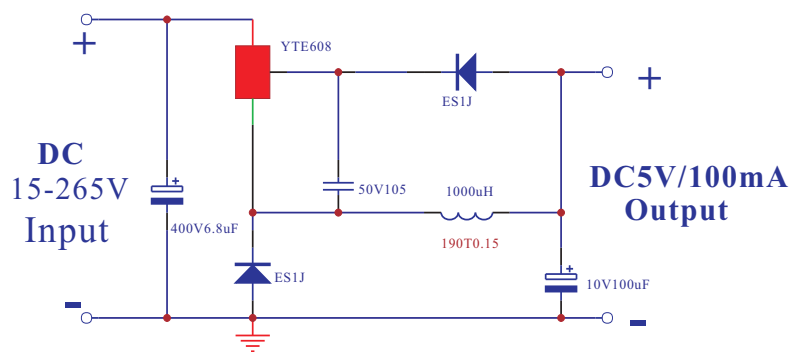
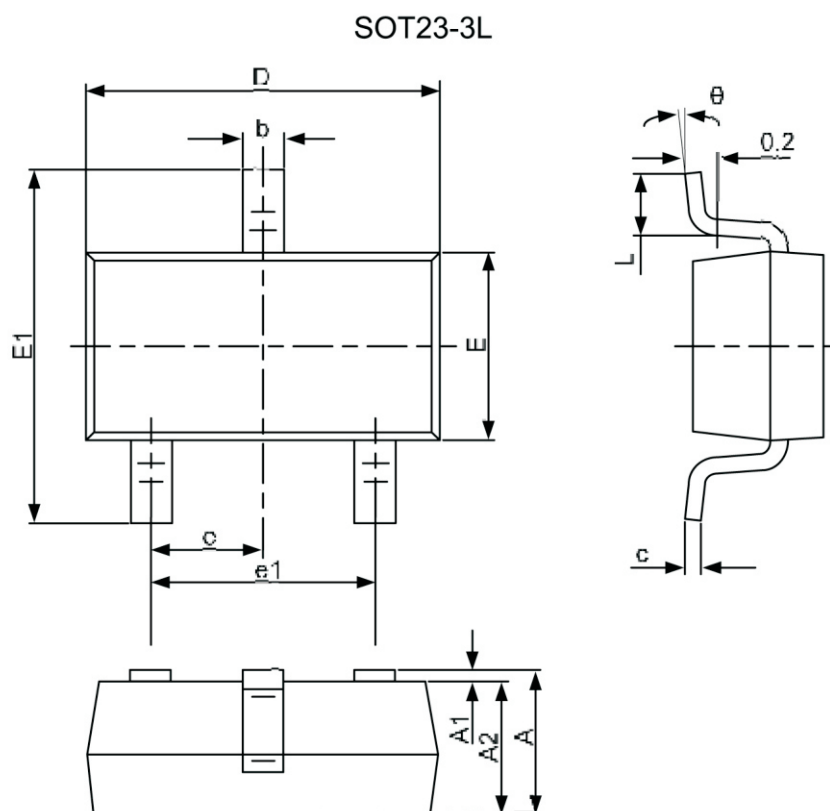


图1典型应用电路图

封装信息



符号	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(中心到中心)		0.037(中心到中心)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

修订记录

日期	版本	描述
2019/10/15	1.0	首次发行

重要声明

本公司不对由电路或图表描述引起的与工业标准，专利或第三方权利相关的问题负有责任。应用电路图仅作为典型应用的

示例用途，并不保证其对专门的大规模生产的实用性。

当该产品及衍生产品与瓦圣那协议或其他国际协议不符时，其出口可能会需要相关政府部门的授权。

未经本公司刊印许可的任何对此处描述信息用于其他用途的复制或拷贝都是严厉禁止的。

此处描述的信息在未获得本公司书面许可的情况下，不能被用于与人体有关的设备，例如运动机械，医疗设备，安全系统，燃气设备，或任何安装于飞机或者其他运输工具。

虽然本公司尽力去完善产品的品质和可靠性，但产品的失效和故障仍在所难免。因此采用该产品的客户必须要进行仔细的安全设计，包括冗余设计，防火设计，失效保护以防止任何次生性意外、火灾或相关损毁。

产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品。